

頁	箇所	誤	正
4	2行目	大文字 K が熱力学温度の単位であるケルビンの記号になっているからです。	これは、 国際単位系の接頭辞が既定される前から小文字が使われていたのと 、大文字 K が熱力学温度の単位であるケルビンの記号になっているからです。
6	式(1.1)	$V = V_m e^{j\omega t} = V_m \cos(\omega t + \phi) + j \sin(\omega t + \phi)$	$V = V_m e^{j(\omega t + \phi)} = V_m \cos(\omega t + \phi) + j \sin(\omega t + \phi)$
71	コラム 6.2 6行目	$f(\Delta x) = f(0) + \frac{df(0)}{dx} \Delta x + \frac{1}{2!} \frac{d^2 f(0)}{dx^2} \Delta x^2 + \frac{1}{3!} \frac{d^3 f(0)}{dx^3} \Delta x^3 + \frac{1}{4!} \frac{d^4 f(0)}{dx^4} \Delta x^4 \dots$	$f(\Delta x) = f(0) + f'(0) \Delta x + \frac{1}{2!} f''(0) \Delta x^2 + \frac{1}{3!} f'''(0) \Delta x^3 + \frac{1}{4!} f^{(4)}(0) \Delta x^4 \dots$
72	コラム 6.2 テイラー展開	$f(x, y, z) \approx f(0, 0, 0) + \frac{\partial f(0, 0, 0)}{\partial x} x + \frac{\partial f(0, 0, 0)}{\partial y} y + \frac{\partial f(0, 0, 0)}{\partial z} z$	$f(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \approx f(0, 0, 0) + \left. \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \right _{x=y=z=0} \Delta x + \left. \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \right _{x=y=z=0} \Delta y + \left. \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \right _{x=y=z=0} \Delta z$
74	コラム 6.3 式(C8.1)	$I'_C = \frac{C_n}{W_B - \Delta W_B} \approx \frac{C_n}{W_B} - \frac{1}{W_B^2} (-\Delta W_B) = \frac{C_n}{W_B} \left(1 + \frac{\Delta W_B}{W_B} \right) = I_C \left(1 + \frac{\Delta W_B}{W_B} \right)$	$I'_C = \frac{C_n}{W_B - \Delta W_B} \approx \frac{C_n}{W_B} - \frac{C_n}{W_B^2} (-\Delta W_B) = \frac{C_n}{W_B} \left(1 + \frac{\Delta W_B}{W_B} \right) = I_C \left(1 + \frac{\Delta W_B}{W_B} \right)$
82	6-7行目	$V_A=100\text{ V}$ とすれば、熱抵抗 U_T を 26 mV (室温) とすると、 $r_C=20\text{ k}\Omega$ 、 $r_E=5.2\ \Omega$ となり、 $r_C \gg r_E$ であると	$V_A=100\text{ V}$ 、 $\alpha=0.9$ とすれば、熱抵抗 U_T を 26 mV (室温) とすると、 $(1-\alpha)r_C = 20\text{ k}\Omega$ 、 $r_E=5.2\ \Omega$ となり、 $(1-\alpha)r_C \gg r_E$ であると
111	下から 2行目	これらを考慮し、コレクタ電圧 V_{C0} が電源電圧の半分の 2.5 V 程度であることから、エミッタ電圧 V_{E0} を 1 V 程度とします。	今回は、 上記のようにエミッタ電圧 V_{E0} が 200 mV であり 、コレクタ電圧 V_{C0} が電源電圧の半分の 2.5 V 程度であることから、コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CE0} は、 2 V 以上確保できます。
135		したがって、通常は負荷抵抗 R_L は高くは設定しません。	(削除)
138	下から 5行目	したがって、ドレイン接地増幅回路の	したがって、 ゲート 接地増幅回路の
141		アーリー電圧 V_A のような指標になり、飽和領域でのドレイン抵抗を表します。	アーリー電圧 V_A のような指標になり、 (チャネル長変調係数×飽和電流値)の逆数

頁	箇所	誤	正
			は、飽和領域でのドレイン抵抗を表します。
155	5行目	(零点の存在)	(高域側における零点の存在)
155	図 9.13(a)	C	C_1
156	式(9.35)	$\frac{v_{B'E}}{v_{in}} = \frac{R_{12}r'_E}{(R_{12} + r'_E)\left(\rho + \frac{1}{j\omega C_1}\right) + R_{12}r'_E}$ $= \frac{1}{\frac{R_{12} + r'_E}{R_{12}r'_E}\left(\rho + \frac{1}{j\omega C_2}\right) + 1}$	$\frac{v_{B'E}}{v_{in}} = \frac{R_{12}r'_E}{(R_{12} + r'_E)\left(\rho + \frac{1}{j\omega C_1}\right) + R_{12}r'_E}$ $= \frac{1}{\frac{R_{12} + r'_E}{R_{12}r'_E}\left(\rho + \frac{1}{j\omega C_1}\right) + 1}$
156	式(9.36)	$\left \frac{R_{12} + r'_E}{R_{12}r'_E}\left(\rho + \frac{1}{j\omega C_2}\right) + 1 \right = \sqrt{2}$	$\left \frac{R_{12} + r'_E}{R_{12}r'_E}\left(\rho + \frac{1}{j\omega C_1}\right) + 1 \right = \sqrt{2}$
159	図 C9.3(a)	0 の位置が右下	0 の位置が左上
166	図 10.4(b)	$g_m v_{GS4}$	$g_{m4} v_{GS4}$
169	式(10.19)	$I_1 = \frac{I_B}{2} + \frac{\Delta I_D}{2}$	$I_1 \approx \frac{I_B}{2} + \frac{\Delta I_D}{2}$
169	式(10.20)	$I_2 = \frac{I_B}{2} - \frac{\Delta I_D}{2}$	$I_2 \approx \frac{I_B}{2} - \frac{\Delta I_D}{2}$
173	1行目	$\frac{1}{R_L // r_D} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_D}$	$\frac{1}{R_D // r_D} = \frac{1}{R_D} + \frac{1}{r_D}$
177	下から 1行目	各トランジスタのチャンネル長変調係数を、 λ_n, λ_p としています。	各トランジスタの $\frac{\Delta I_D}{\Delta V_{DS}}$ を、 λ_n, λ_p としています。
178	14行目	傾きを表しているといいました。つまり、その逆数(1/λ)はMOSFETのドレイン抵抗を表します。	傾きに関係しているといいました。つまり、上記の λ_p や λ_n の逆数は、MOSFETのドレイン抵抗を表します。
186	図 11.4	オペアンプの入力において、上側が+で下側が-	オペアンプの入力において、上側が-で下側が+
187	式(11.18)	$V_{out} = -\left(\frac{R_F}{R_1} V_{in1} + \frac{R_F}{R_1} V_{in2}\right)$	$V_{out} = -\left(\frac{R_F}{R_1} V_{in1} + \frac{R_F}{R_2} V_{in2}\right)$
193	式(11.38) の下	抵抗はkΩ、容量はpF、トランスコンダクタンスはmSオーダーと考えると、	抵抗は数十~数百kΩ、容量は数pF、トランスコンダクタンスは数~数十mSと考えると、
204	3行目	一方、どのような負帰還回路でも遅延時間 t_d は存在するので、周波数を上げていくと、	一方、第9章などで示したように、ポールが複数あるオペアンプにおいて、周波数を上げていくと、
208	11行目	となり、これと式(12.19)より、以下の関係が導けます。	となり、これと式(12.17)より、以下の関係が導けます。
248	下から 2, 3行目	$I_{1a} = \frac{14}{8 + \frac{4 \times 2}{4 + 2}} = \frac{14}{8 + \frac{4}{3}} = \frac{42}{28} = \frac{3}{2} \text{ V/k}\Omega$ よって、 $I_{1a} = 1.5 \text{ mA}$	$I_{1a} = \frac{-14}{8 + \frac{4 \times 2}{4 + 2}} = \frac{-14}{8 + \frac{4}{3}} = \frac{-42}{28} = -\frac{3}{2} \text{ V/k}\Omega$ よって、 $I_{1a} = -1.5 \text{ mA}$

頁	箇所	誤	正
249	5行目	$I_1 = I_{1a} + I_{1b} = 1.5 + 0.5 = 2 \text{ mA}$	$I_1 = I_{1a} + I_{1b} = -1.5 + 0.5 = -1 \text{ mA}$
254	4行目	<p>これより, $R_1 = \frac{V_{CC}-V_B}{\frac{V_B}{R_2}+I_{B0}} = 9.9 \text{ k}\Omega$となる.</p> <p>$R_1 = 10 \text{ k}\Omega$として, $R_1//R_2 = 1.7 \text{ k}\Omega$となり, S_βは, 0.32 くらいとなる. このときの I_{R2}は, $812 \text{ mV}/2 \text{ k}\Omega = 406 \mu\text{A}$となり, I_{B0}の 10 倍くらいとなる.</p>	<p>これは, 電源電圧 10 V の 10 分の 1 程度のため, R_1は, R_2の 10 倍程度と思われるので, R_2は, $R_{in}(=R_1//R_2)$の 1.1 倍程度だと考えられる.</p> <p>したがって, 公称抵抗値を考慮して $R_2 = 1.8 \text{ k}\Omega$とする.</p> <p>これより, $R_1 = \frac{V_{CC}-V_B}{\frac{V_B}{R_2}+I_{B0}} = 20.4 \text{ k}\Omega$となる.</p> <p>$R_1 = 20 \text{ k}\Omega$として, $R_1//R_2 = 1.65 \text{ k}\Omega$となり, S_βは, 0.33 くらいとなる. このときの I_{R2}は, $812 \text{ mV}/1.8 \text{ k}\Omega = 450 \mu\text{A}$となり, I_{B0}の 25 倍くらいとなる.</p>